

2SB1275F5

查询"2SB1275F5"供应商

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ  
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor  
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.

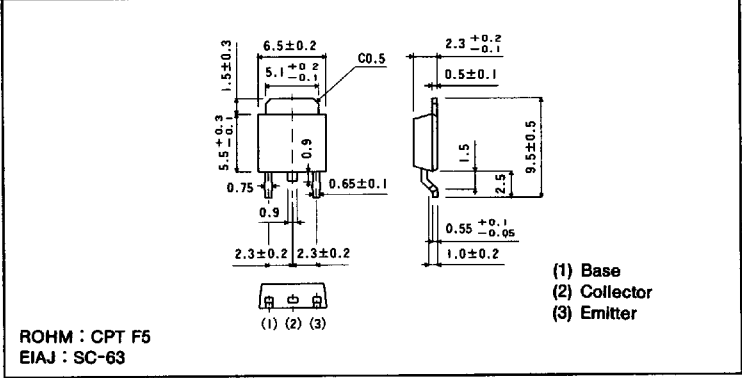
● 特長

- 1) 高耐圧である。  
BVCEO=-160V
- 2) SOA が広く、 $f_T$  が高い。
- 3) Cob が小さい。
- 4) 2SD1918F5 とコンプリである。

● Features

- 1) High breakdown voltage :  
BVCEO=-160V
- 2) Wide SOA, and high transition frequency.
- 3) Small output capacitance.
- 4) Complementary pair with 2SD1918F5

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

| Parameter    | Symbol           | Limits  | Unit        |
|--------------|------------------|---------|-------------|
| コレクタ・ベース間電圧  | V <sub>CB0</sub> | -160    | V           |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | V <sub>CEO</sub> | -160    | V           |
| エミッタ・ベース間電圧  | V <sub>EBO</sub> | -5      | V           |
| コレクタ電流       | I <sub>C</sub>   | -1.5    | A           |
|              | I <sub>CP</sub>  | -3      | A*1         |
| コレクタ損失       | P <sub>C</sub>   | 1.0     | W           |
|              |                  | 10      | W (Tc=25°C) |
| 接合部温度        | T <sub>j</sub>   | 150     | °C          |
| 保存温度範囲       | T <sub>stg</sub> | -50~150 | °C          |

\*1 single pulse P<sub>W</sub>=100ms

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

| Parameter     | Symbol                  | Min. | Typ. | Max. | Unit | Conditions                                          |
|---------------|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------|
| コレクタ・ベース降伏電圧  | BV <sub>CB0</sub>       | -160 | —    | —    | V    | I <sub>C</sub> =-50μA                               |
| コレクタ・エミッタ降伏電圧 | BV <sub>CEO</sub>       | -160 | —    | —    | V    | I <sub>C</sub> =-1mA                                |
| エミッタ・ベース降伏電圧  | BV <sub>EBO</sub>       | -5   | —    | —    | V    | I <sub>E</sub> =-50μA                               |
| コレクタシャ断電流     | I <sub>CBO</sub>        | —    | —    | -1.0 | μA   | V <sub>CB</sub> =-160V                              |
| エミッタシャ断電流     | I <sub>EBO</sub>        | —    | —    | -1.0 | μA   | V <sub>EB</sub> =-4V                                |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | V <sub>CE(sat)</sub> *1 | —    | —    | -1.0 | V    | I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub> =-1A/-0.1A           |
| ベース・エミッタ飽和電圧  | V <sub>BE(sat)</sub> *1 | —    | —    | -1.5 | V    | I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub> =-1A/-0.1A           |
| 直流電流増幅率       | h <sub>FE</sub>         | 56   | —    | 270  | —    | V <sub>CE</sub> /I <sub>C</sub> =-5V/-0.1A          |
| 利得帯域幅積        | f <sub>T</sub>          | —    | 50   | —    | MHz  | V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>E</sub> =0.1A, f=30MHz |
| 出力容量          | C <sub>ob</sub>         | —    | 40   | —    | pF   | V <sub>CB</sub> =-10V, I <sub>E</sub> =0A, f=1MHz   |

\*1 パルス測定

h<sub>FE</sub> の値により下表のように分類します。

| Item            | N      | P      | Q       |
|-----------------|--------|--------|---------|
| h <sub>FE</sub> | 56~120 | 82~180 | 120~270 |

## ● 標準品・準標準品一覧表

(○: 準標準品)

| Type      | hFE | 記号        | TL   | TR   | F5   |
|-----------|-----|-----------|------|------|------|
|           |     | 基本発注単位(個) | 2500 | 2500 | 2000 |
| 2SB1275F5 | PQR |           | ○    | ○    | ○    |

[查詢"2SB1275F5"供應商](#)

## ● 電氣的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

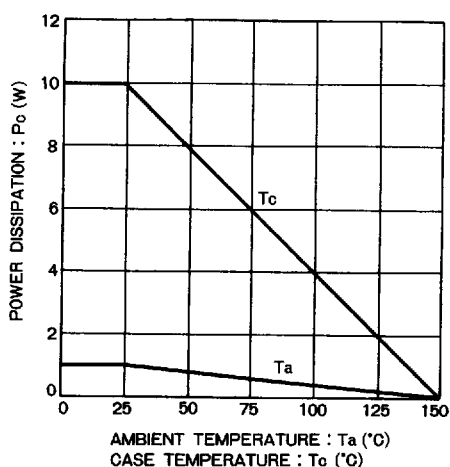


Fig.1 電力軽減曲線

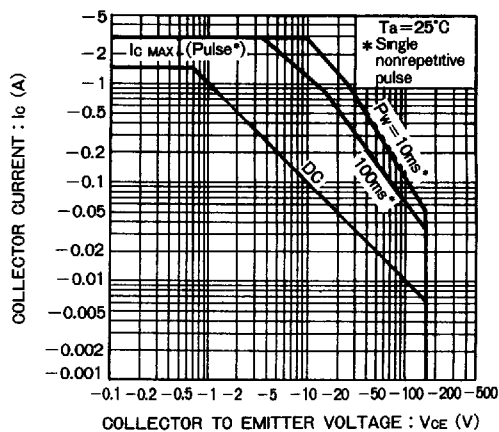


Fig.2 安全動作領域

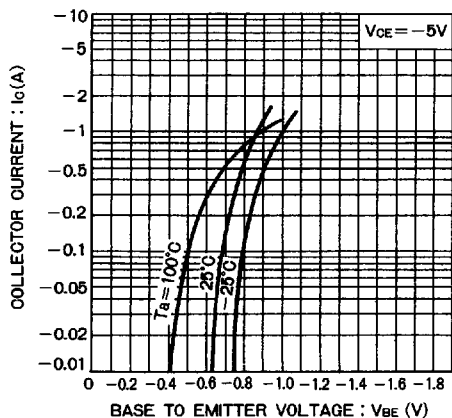


Fig.3 エミッタ接地伝達静特性

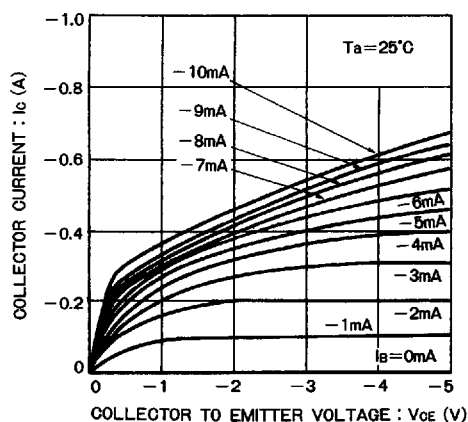


Fig.4 エミッタ接地出力静特性

[查询"2SB1275F5"供应商](#)

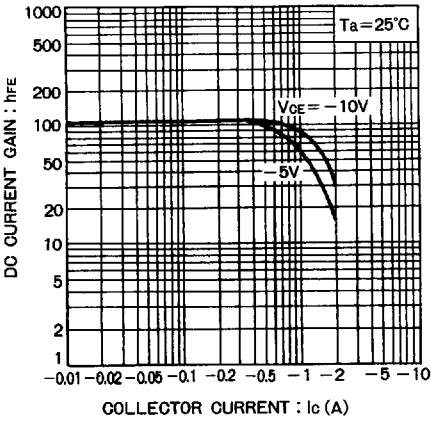


Fig.5 直流電流増幅率-コレクタ電流特性 (I)

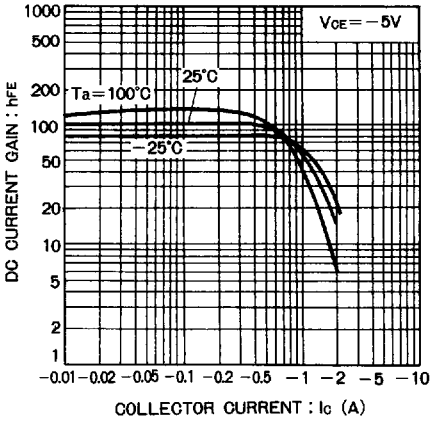


Fig.6 直流電流増幅率-コレクタ電流特性 (II)

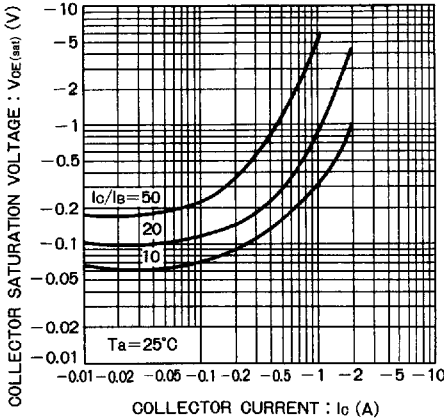


Fig.7 コレクタ・エミッタ間飽和電圧-コレクタ電流特性

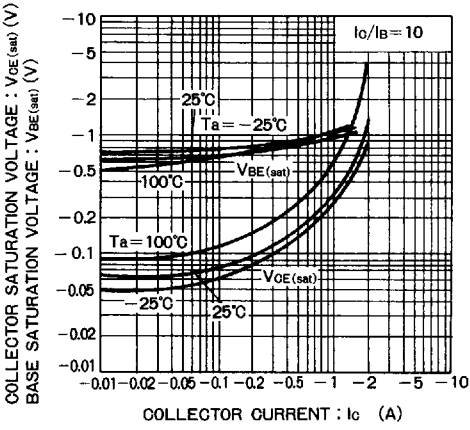


Fig.8 コレクタ・エミッタ間飽和電圧-コレクタ電流特性  
ベース・エミッタ間飽和電圧

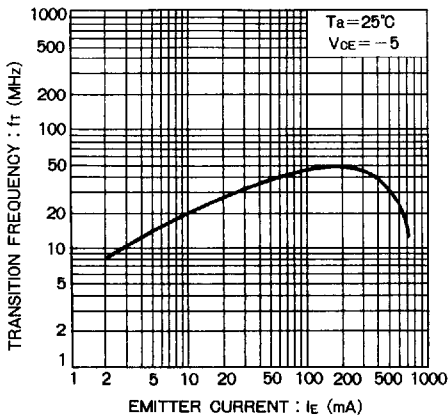


Fig.9 利得帯域幅積-エミッタ電流特性

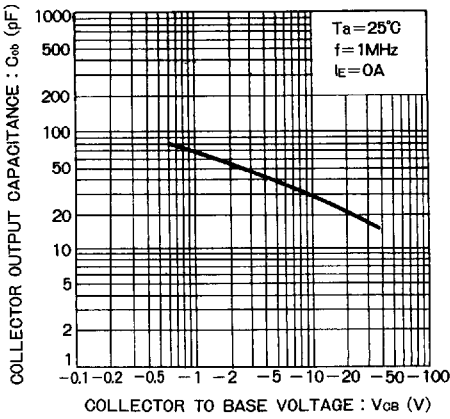


Fig.10 コレクタ出力容量-コレクタ・ベース間電圧特性

トランジスタ  
2SBタイプ